

$$\varepsilon\beta E_0 = -E_0 - \frac{2\alpha}{a^3} \quad (12)$$

Решая алгебраическую систему (11)–(12), получаем значения α и β .

$$\alpha = a^3 E_0 \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2}, \quad \beta = -\frac{3}{\varepsilon + 2},$$

после чего можем записать потенциал поля в окончательной форме:

$$\varphi_1 = -\frac{3}{\varepsilon + 2} E_0 r \cos \vartheta; \quad (13)$$

$$\varphi_2 = E_0 \left(-r + \frac{a^3}{r^2} \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} \right) \cos \vartheta. \quad (14)$$

Найденные потенциалы φ_1 и φ_2 дают ответ на поставленную задачу — по ним определяется напряженность поля:

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r}, \quad E_\vartheta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \vartheta}.$$

(Вычисления напряженностей мы предоставляем читателю.)

Весьма интересно придать потенциалам (13) и (14) иную форму, вводя в рассмотрение вектор

$$\vec{P} = \frac{3}{4\pi} \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} \vec{E}_0,$$

оказывающийся вектором поляризации шара в данном случае. После подстановки получаем

$$\varphi_1 = -\vec{E}_0 \vec{r} + \frac{4\pi r^3}{3} \frac{\vec{P} \vec{r}}{r^3},$$

$$\varphi_2 = -\vec{E}_0 \vec{r} + \frac{4\pi a^3}{3} \frac{\vec{P} \vec{r}}{r^3}.$$

Но эти формулы в явном виде представляют поле как суперпозицию исходного поля \vec{E}_0 и поля однородного поляризованного шара с дипольным моментом $\vec{P}V$ (внутри шара берется $V' = \frac{4\pi r^3}{3}$).

Можно найти и плотность связанных зарядов на поверхности шара, если воспользоваться формулой (17.14). Поскольку

$$E_r = E \cos \vartheta,$$

то

$$\sigma_{св} = \frac{3}{4\pi} \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} E_0 \cos \vartheta.$$

§ 18. Проводники в электростатическом поле

18.1. Уединенный проводник. Емкость. Еще из школьного курса физики известно, что проводник, помещенный в электростатическое поле, заряжается по поверхности. В отсутствии поля

плотность свободных зарядов в проводнике равна нулю, так как в любом макроскопическом объеме число положительных и отрицательных зарядов одинаково.

Это, однако, не означает, что свободных зарядов нет: в проводнике имеется очень большое количество утерявших связь с ядрами электронов. Под действием внешнего поля $\vec{E}_в$ они движутся до поверхности проводника, создавая здесь отличную от нуля плотность заряда σ . Соответственно возникает поле этих зарядов с напряженностью \vec{E}' . Движение зарядов продолжается до тех пор, пока поле внутри проводника не исчезнет, т. е. будет

$$\vec{E} = \vec{E}_в + \vec{E}' = 0.$$

В таком случае из формул (17.1) следует, что $\rho = 0$, т. е. объемная плотность свободных зарядов внутри проводника равна нулю.

Таким образом, речь идет о случаях, когда внутренних свободных зарядов достаточно для создания напряженности $\vec{E}' = -\vec{E}_в$. Впрочем, это выполняется практически всегда.

Этот вывод справедлив в статическом случае и для заряженного проводника: все помещенные на него заряды располагаются на поверхности.

Возможно сопоставление с однородным диэлектриком в однородном электростатическом поле: поляризация приводит к образованию только поверхностных связанных зарядов. Но если в диэлектрике поле ослаблено по сравнению с вакуумом в ϵ раз, то в проводнике оно вообще отсутствует, т. е. можно формально считать для проводника $\epsilon = \infty$.

Итак, все нескомпенсированные свободные заряды расположены на поверхности проводника, они образуют тонкий электрический слой порядка размеров атома. Из граничного условия (16.10) вытекает для проводника важное заключение:

$$\epsilon \epsilon_0 E_n = \sigma, \quad (18.1)$$

которое дает связь напряженности поля снаружи на поверхности проводника с поверхностной плотностью заряда. Тангенциальная составляющая напряженности поля вне проводящего тела в силу граничного условия (16.17) равна нулю, так как напряженность поля внутри проводника равна нулю:

$$E_t = 0. \quad (18.2)$$

Подводя итог, заключаем: линии напряженности электростатического поля перпендикулярны поверхности проводника и начинаются или оканчиваются на зарядах, расположенных на этой поверхности:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0} \vec{n}, \quad (18.3)$$

где ε – диэлектрическая проницаемость среды, окружающей проводник, а \vec{n} – единичный вектор внешней нормали к поверхности (рис. 18.1).

Вследствие того, что внутри проводника напряженность равна нулю, потенциал всех точек проводника один и тот же. (Это непосредственно видно из формулы связи потенциала и напряженности $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$.) Таким образом, можно говорить о потенциале всего проводящего тела (вместо потенциала точки поля).

Запишем выражение (17.7) для потенциала системы зарядов, распределенных по поверхности проводника, учитывая, что проводник окружен однородным диэлектриком:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{k}{\varepsilon} \oint_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dS'$$

Поместим начало координат в точке наблюдения M . Тогда формула упростится:

$$\varphi(0) = \frac{k}{\varepsilon} \oint_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{r} dS'. \quad (18.4)$$

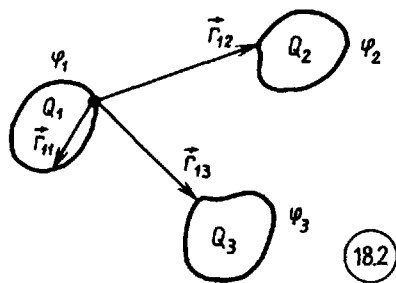
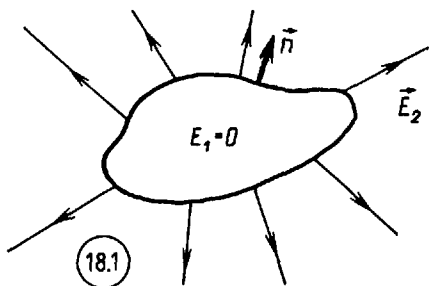
Если точка наблюдения находится в пределах проводника, то должно получиться значение φ , не зависящее от выбора точки. Это приводит к пропорциональности потенциала φ заряду проводника. Введем определение новой физической величины – *емкости проводника* – формулой

$$\varphi = \frac{Q}{C}, \quad (18.5)$$

где Q – заряд проводника, а C – его емкость. Из соображений размерности следует

$$C = \frac{\varepsilon}{k} \langle r \rangle. \quad (18.6)$$

В формуле (18.6) $\langle r \rangle$ – величина с размерностью длины. Этот параметр имеет смысл некоторых средних линейных размеров, характе-



ризирующих тело, так как расстояния до точек на поверхности проводника входят в интеграл (18.4). Конечно, емкость не зависит от величины заряда на проводнике, а определяется согласно формуле (18.6) размерами, формой проводника и окружающим диэлектриком.

Для практического определения емкости следует пользоваться формулой (18.5). С помощью же формулы (18.6) расчет емкости можно провести только для тела простейшей формы. Пусть шарообразный проводник находится в вакууме, тогда $\epsilon = 1$; заряд распределяется по поверхности равномерно, а $\langle r \rangle = R$, т. е.

$$C = \frac{R}{k}.$$

Единица емкости — 1 фарад (Ф):

$$1 \text{ Ф} = 1 \text{ м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2.$$

Фарад — это емкость шара радиусом $9 \cdot 10^9$ м.

18.2*. Система проводников. При наличии в пространстве нескольких заряженных проводников потенциал каждого из них зависит от расположения зарядов в пространстве, т. е. от расстояний до других проводников, их формы и размеров, от диэлектрической проницаемости среды, разделяющей проводники. Чтобы непосредственно убедиться в этом, рассмотрим систему проводников, помещенных в однородный диэлектрик (рис. 18.2), и применим для нахождения потенциала одного из проводников формулу (18.4):

$$\varphi_i = \frac{k}{\epsilon} \sum_{j=1}^N \oint_{S_j} \frac{\sigma(\vec{r}_{ij})}{r_{ij}} dS_j. \quad (18.7)$$

Повторяя рассуждения, проведенные в предыдущем параграфе, вместо формулы (18.7) можно записать:

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} Q_j, \quad (18.8)$$

где α_{ij} постоянные коэффициенты. Все $\alpha_{ij} \geq 0$, причем $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$ (теорема взаимности, доказательство которой мы опускаем).

Решим систему алгебраических уравнений (18.8) относительно зарядов, в результате чего получим по формулам линейной алгебры

$$Q_i = \sum_{j=1}^N C_{ij} \varphi_j. \quad (18.9)$$

Здесь

$$C_{ij} = \frac{A_{ij}}{D},$$

где D — определитель матрицы коэффициентов α_{ij} ; A_{ij} — алгебраическое дополнение к элементу α_{ij} .

Коэффициенты C_{ij} зависят от формы и размеров тел, их взаим-

ного расположения, диэлектрических свойств среды. Величины C_{ii} называются *коэффициентами емкости*, а C_{ij} — *коэффициентами индукции*. Можно показать, что $C_{ij} = C_{ji}$. Кроме того, оказывается, что $C_{ii} > 0$, $C_{ij} \leq 0$.

Пример 18.1. Система двух проводников — конденсатор.

Исследуем систему из двух проводников при условии, что заряды на них равны по модулю и противоположны по знаку. Согласно формуле (18.9)

$$-Q = C_{1,1} \varphi_1 + C_{1,2} \varphi_2; \quad (1)$$

$$Q = C_{2,1} \varphi_1 + C_{2,2} \varphi_2. \quad (2)$$

Положим $\varphi_2 = 0$. Складывая равенства (1) и (2) и учитывая, что $C_{1,2} = C_{2,1}$, получим

$$C_{1,1} = -C_{1,2}.$$

Аналогично: если выбрать $\varphi_1 = 0$, то окажется

$$C_{2,2} = -C_{1,2},$$

откуда следует, что $C_{1,1} = C_{2,2}$. Таким образом,

$$C_{1,1} = C_{2,2} = -C_{1,2} = -C_{2,1} = C.$$

Система, состоящая из двух проводников с равными по модулю зарядами, называется конденсатором. Как из равенства (1), так и из равенства (2) для конденсатора следует

$$C = \frac{Q}{\varphi_2 - \varphi_1}. \quad (18.10)$$

Величину C называют емкостью конденсатора. Всегда $C > 0$. Поэтому в формуле (18.10) предполагается, что φ_2 — потенциал той обкладки, заряд которой положителен. Конденсатор может быть изолирован от влияния других тел в пространстве, т. е. емкость определяется только параметрами самого конденсатора.

Пример 18.2. Расчет поля при наличии в нем проводящего тела.

Рассмотрим на простом примере решение задачи электростатики с проводящим телом. Для этого воспользуемся данными примера 17.6, но вместо шара из диэлектрика поместим в однородное поле проводящий шар.

Внс шара используем решение уравнения Лапласа, найденное в задаче 17.6:

$$\varphi = \left(C_1 r + \frac{C_2}{r^2} \right) \cos \vartheta. \quad (1)$$

Постоянные коэффициенты C_1 и C_2 следует определить из граничных условий. Вдали от шара

$$\vec{E} |_{r \rightarrow \infty} = \vec{E}_0,$$

откуда

$$\varphi |_{r \rightarrow \infty} = -\vec{E}_0 \vec{r},$$

$$-C_1 = E_0. \quad (2)$$

Потенциал проводника должен быть конечной постоянной величиной. На поверхности шара

$$\varphi = \left(C_1 a + \frac{C_2}{a^2} \right) \cos \vartheta = \text{const},$$

что дает

$$C_1 a + \frac{C_2}{a^2} = 0,$$

откуда

$$C_2 = E_0 a^3 \quad (3)$$

Итак, потенциал поля определяется формулой

$$\varphi = E_0 \left(-r + \frac{a^3}{r^2} \right) \cos \vartheta \quad (4)$$

Нетрудно найти и составляющие напряженности поля. В сферической системе координат

$$\begin{aligned} E_r &= -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = E_0 \left(1 + \frac{2a^3}{r^3} \right) \cos \vartheta, \\ E_\vartheta &= -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \vartheta} = E_0 \left(\frac{a^3}{r^3} - 1 \right) \sin \vartheta, \\ E &= E_0 \sqrt{\left(1 + \frac{2a^3}{r^3} \right)^2 \cos^2 \vartheta + \left(\frac{a^3}{r^3} - 1 \right)^2 \sin^2 \vartheta} \end{aligned} \quad (5)$$

При $r = a$, углах $\vartheta = 0$ и $\vartheta = \pi$ имеем $E = E_{\max} = 3E_0$. На «экваторе» шара $E = E_{\min} = 0$. Заряд распределяется по поверхности шара с плотностью

$$\sigma = 3\epsilon_0 E_0 \cos \vartheta \quad (6)$$

(Следует учесть, что проводник находится в вакууме)

Осталось заметить, что эти результаты мы могли бы получить, не решая задачу для проводника вновь, а используя потенциал поля, найденный в примере 17.6, и полагая в формуле (14) $\epsilon = \infty$

18.3. Энергия электростатического поля как энергия взаимодействия системы тел. Запишем выражение для энергии электростатического поля в веществе, полученное из общей формулы (16.22):

$$W = \frac{1}{2} \int \vec{D} \vec{E} dV. \quad (18.11)$$

Пусть в однородной диэлектрической среде имеется некоторая система однородных тел конечных размеров, на которых и сосредоточены электрические заряды. В таком случае все пространство заполнено кусочно-однородным веществом.

Преобразуем формулу (18.11), вводя скалярный потенциал вместо напряженности и используя тождество (см. П. II, 15). Получаем

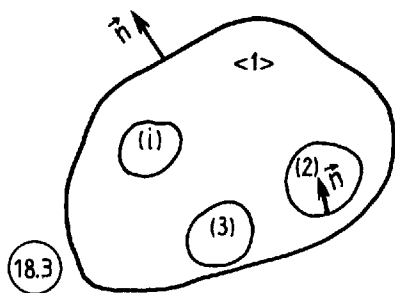
$$-\vec{D} \text{grad } \varphi = \varphi \text{div } \vec{D} - \text{div} (\varphi \vec{D}).$$

Применяя уравнения (17.1), находим

$$W = \frac{1}{2} \int \varphi \rho dV - \frac{1}{2} \int \text{div} (\varphi \vec{D}) dV.$$

Далее запишем интегралы, подразделяя область интегрирования на части в соответствии с рисунком 18.3, причем область (1) охватывает всю рассматриваемую среду, а области (2), (3) и т. д. — тела в ней:

$$W = \frac{1}{2} \int_{V_1} \varphi \rho dV + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^N \int_{V_i} \varphi \rho dV - \frac{1}{2} \int_{V_1} \text{div} (\varphi \vec{D}) dV - \frac{1}{2} \sum_{i=2}^N \int_{V_i} \text{div} (\varphi \vec{D}) dV. \quad (18.12)$$



Первое слагаемое в формуле (18.12) равно нулю, так как заряды расположены только на телах. Третье слагаемое представим в виде суммы поверхностных интегралов:

$$-\frac{1}{2} \int_{V_1} \operatorname{div}(\varphi \vec{D}) dV = -\frac{1}{2} \oint_{S_1} \varphi D_n dS - \frac{1}{2} \sum_{i=2}^N \oint_{S_i} \varphi D_n dS.$$

Поверхностный интеграл по внешней границе обращается в нуль, если поверхность S_1 сдвинуть в бесконечность, т. е. учесть всю протяженность поля.

Объемные интегралы вида

$$\int_{V_i} \operatorname{div}(\varphi \vec{D}) dV$$

также сводятся к поверхностным:

$$-\frac{1}{2} \sum_{i=2}^N \int_{V_i} \operatorname{div}(\varphi \vec{D}) dV = \frac{1}{2} \sum_{i=2}^N \oint_{S_i} \varphi D_n dS.$$

(Знак сменился потому, что выбранная нормаль \vec{n}_i для всех областей $i = 2, 3, \dots, N$ является внутренней.) При подстановке полученных выражений в формулу (18.12) сгруппируем поверхностные интегралы по индексу области. Например, для области (2) получим член

$$\frac{1}{2} \oint_{S_2} \varphi (D_{n_2} - D_{n_1}) dS,$$

который с помощью граничного условия (16.9) преобразуется в выражение

$$\frac{1}{2} \oint_{S_2} \varphi \sigma dS.$$

В итоге формула для энергии поля системы заряженных тел в среде приобретает вид

$$W = \frac{1}{2} \sum_k \int_{V_k} \varphi \rho dV + \frac{1}{2} \sum_k \oint_{S_k} \varphi \sigma dS, \quad (18.13)$$

где суммирование производится по всем заряженным телам системы. Полученный вывод замечателен тем, что сводит энергию электростатического поля заряженных тел к энергии системы свободных зарядов в поле с потенциалом $\varphi(\vec{r})$. В этом отношении формула (18.13) аналогична формуле энергии системы зарядов в вакууме (7.14). Однако теперь связанные заряды, входящие в состав вещества, учитываются в значениях потенциалов, уменьшая потенциал, а вместе с ним и энергию системы (см. § 17, п. 17.1).

Формула (18.13) подходит к диэлектрическим телам, на которых свободный заряд может быть распределен как по объему, так и по поверхности. (Если в системе есть заряженные нити, то следует учесть также слагаемые вида $\int_{L_k} \varphi \tau dl$.)

Система заряженных проводников в вакууме или диэлектрической среде за счет распределенной по пространству энергии электростатического поля обладает энергией, которую можно рассматривать как потенциальную энергию взаимодействия заряженных проводников. В самом деле, если воспользоваться формулой энергии системы заряженных тел (18.13) и учесть, что заряды распределены только по поверхностям проводников, а потенциалы каждого проводника одинаковы во всех точках, то сразу получим

$$W = \frac{1}{2} \sum_k \varphi_k \oint_{S_k} \sigma dS = \frac{1}{2} \sum_k \varphi_k Q_k. \quad (18.14)$$

Формально (18.14) совпадает с формулой (7.10) — выражением для энергии системы точечных зарядов в вакууме.

Если использовать выражение для зарядов проводника через коэффициенты емкости и индукции (18.9), то формула (18.14) для энергии системы проводников примет вид

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \varphi_i \sum_{k=1}^N C_{ik} \varphi_k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N C_{ik} \varphi_i \varphi_k. \quad (18.15)$$

Формула (18.15) для уединенного проводника приводит к известному из курса общей физики выражению

$$W = \frac{C\varphi^2}{2}. \quad (18.15-a)$$

То же выражение мы получим для конденсатора, где в качестве φ фигурирует разность потенциалов между обкладками, а C — емкость.

18.4. Силы, действующие на тела в электростатическом поле.

Сила, действующая на (твердое) тело в электрическом поле, опреде-

ляется равнодействующей сил, действующих на свободные и связанные заряды в элементах объема тела:

$$\vec{F} = \int_V \vec{E} (q + q_{\text{св.з}}) dV. \quad (18.16)$$

В § 7, п. 7.2 рассмотрены силы, действующие на систему зарядов в поле. Сейчас мы найдем силы, действующие в электрическом поле на тела и вещественную среду, учитывая специфику распределения зарядов в диэлектриках и проводниках.

В твердом диэлектрике электрические заряды жестко связаны. Поэтому можно применить формулу (7.8)

$$\vec{F} = (\vec{p} \nabla) \vec{E},$$

где \vec{p} — дипольный момент системы, а \vec{E} — напряженность поля. Для незаряженного, но поляризованного диэлектрика дипольный момент элементарного объема dV определяется формулой (15.1)

$$d\vec{p} = \vec{P} dV,$$

где \vec{P} — вектор поляризации вещества. Для элементарной силы получим

$$d\vec{F} = (\vec{P} \nabla) \vec{E} dV.$$

Учитывая материальное уравнение (15.8), имеем

$$d\vec{F} = \chi \varepsilon_0 (\vec{E} \nabla) \vec{E} dV.$$

Учитывая тождество (см. П. II, 29) и уравнения поля (17.1), можно показать, что

$$\text{grad} (\vec{E} \vec{E}) = 2 (\vec{E} \nabla) \vec{E} + 2 [\vec{E} \text{rot} \vec{E}] = 2 (\vec{E} \nabla) \vec{E}.$$

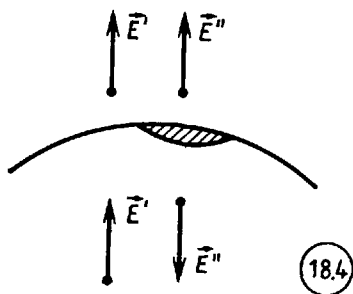
Тогда для плотности силы $\vec{f} = \frac{d\vec{F}}{dV}$ получим

$$\vec{f} = \frac{\chi \varepsilon_0}{2} \text{grad} E^2. \quad (18.17)$$

Характерно, что направление силы не зависит от направления силовых линий; она направлена всегда в сторону возрастания модуля напряженности поля, т. е. диэлектрик как бы втягивается в поле.

Найдем теперь силу, действующую на проводник, помещенный в электрическое поле. Так как заряды сосредоточены на поверхности проводника, то соответственно и поле действует на поверхность проводника. Напряженность поля на поверхности проводника выражена формулой (18.3)

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0} \vec{n}.$$



Однако для расчета силы, действующей на некоторую малую площадку поверхности проводника, нужно знать не эту величину, а напряженность поля \vec{E}' , созданного всеми зарядами, за вычетом заряда данной площадки. Применим следующий прием: мысленно вырежем некоторую площадку (рис. 18.4) вместе с зарядом на ней и исключим действие ее заряда на поле. Тогда в данном месте при переходе границы тела скачка напряженности не будет: напряженность \vec{E}' окажется непрерывной величиной. Пусть площадка создает поле напряженностью \vec{E}'' , как показано на рисунке. Внутри проводника $\vec{E} = \vec{E}' + \vec{E}'' = 0$, т. е. $\vec{E}'' = -\vec{E}'$; следовательно, при наличии площадки снаружи тела $\vec{E} = \vec{E}' + \vec{E}'' = 2\vec{E}'$, а $\vec{E}' = \frac{\vec{E}}{2}$.

Вычислим элементарную силу, действующую на площадку dS :

$$d\vec{F} = \vec{E}' \sigma dS = \frac{\sigma^2}{2\epsilon \epsilon_0} \vec{n} dS.$$

Для плотности силы имеем выражение

$$\vec{f}_{\text{пов}} = \frac{d\vec{F}}{dS} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon \epsilon_0} \vec{n}. \quad (18.18)$$

Его можно преобразовать, принимая в расчет формулу (18.3). Получаем

$$f_{\text{пов}} = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2}, \quad (18.19)$$

т. е. модуль плотности силы равен плотности энергии поля у поверхности проводника.

Методические указания и рекомендации

I. Электростатическое поле является наиболее подробно изучаемым из всей электродинамики объектом в курсе средней школы и в курсе общей физики. Для него вводятся основные характеристики — напряженность и потенциал, рассматривается теорема Гаусса и т. д. Кроме того, анализируется явление поляризации, электростатической индукции.